SHAY, www.vishay.com

Optocoupler

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

VISHAY Semiconductor GmbH Theresienstraße 2 74072 Heilbronn Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt / is authorized to use for their product

> Optokoppler Optocoupler

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen / the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach / Tested and certified according to

DIN EN IEC 60747-5-5 (VDE 0884-5):2021-10; EN IEC 60747-5-5:2020

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: VDE certificates are valid only when published on:



 Aktenzeichen:
 422610-4880-0048 / 297224

 File ref.:
 Ausweis-Nr.
 91888
 Blatt
 1

 Certificate No.
 Page
 Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter / further conditions see overleef and following pages Offenbach, 1996-04-15 (letzte Änderung/updated 2022-11-04)

http://www.vde.com/zertifikat http://www.vde.com/certificate



Revision: 02-Dec-2022

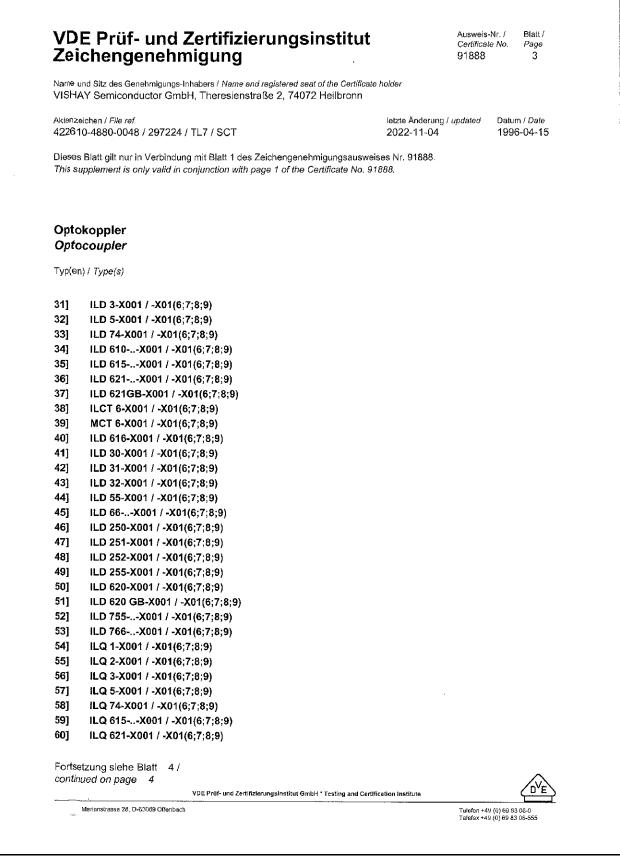
1 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> Document Number: 83576



	E Prüf- und Zertifizierungsinstitut chengenehmigung	Ausweis- Certificat 91888	
	und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate . AY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn	holder	
	eichen / File ref. 10-4880-0048 / 297224 / TL7 / SCT	letzte Änderung <i>/ updated</i> 2022-11-04	Datum / <i>Date</i> 1996-04-15
	s Blatt glit nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweis upplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 916		
•	okoppler oco <i>upler</i>		
Typ(ei	n) / Type(s)		
1]	SFH 6106X001 / -X01(6;7;8;9)		
2]	SFH 6116X001 / -X01(6;7;8;9)		
3]	SFH 6156X001 / -X01(6;7;8;9)		
4]	SFH 6186X001 / -X01(6;7;8;9)		
5]	SFH 610AX001 / -X01(6;7;8;9)		
6]	SFH 611AX001 / -X01(6;7;8;9)		
7]	SFH 615AX001 / -X01(6;7;8;9)		
8] ~7	SFH 617AX001 / -X01(6;7;8;9)		
9] 101	SFH 618AX001 / -X01(6;7;8;9)		
10]	SFH 610AE., -X001 / -X01(6;7;8;9)		
11] 12]	SFH 615AA-X001 / -X01(6;7;8;9)		
13]	SFH 615AGB-X001 / -X01(6;7;8;9) SFH 615AGR-X001 / -X01(6;7;8;9)		
14]	SFH 612A-X001 / -X01(6;7;8;9)		
15]	SFH 619A-X001 / -X01(6;7;8;9)		
16]	SFH 655A-X001 / -X01(6;7;8;9)		
17]	SFH 614A-X001 / -X01(6;7;8;9)		
18]	SFH 615ABM-X001 / -X01(6;7;8;9)		
19]	SFH 615ABL-X001 / -X01(6;7;8;9)		
20]	SFH 615AY-X001 / -X01(6;7;8;9)		
21]	SFH 615AB-X001 / -X01(6;7;8;9)		
22]	SFH 615BC-X001 / -X01(6;7;8;9)		
23]	SFH 6206X001 / -X01(6;7;8;9)		
24]	SFH 6286X001 / -X01(6;7;8;9)		
25]	SFH 620AX001 / -X01(6;7;8;9)		
26] 1771	SFH 628AX001 / -X01(6;7;8;9)		
27] 291	SFH 620AA-X001 / -X01(6;7;8;9)		
28] 29]	SFH 620AGB-X001 / -X01(6;7;8;9) ILD 1-X001 / -X01(6;7;8;9)		
29] 30]	ILD 2-X001 / -X01(6;7;8;9)		
1			
	etzung siehe Blatt 3 /		
contir	ued on page 3		
	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certific	ation institute	<u>L</u>

Document Number: 83576





www.vishay.com

Document Number: 83576



1

Zei	E Prüf- und Zertifizierungsinstitut ichengenehmigung	Certificat 91888	te No. Page 4
	und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / <i>Name and registered seat of the Certificate</i> AY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn	holder	
	eichen / <i>File ref.</i> 10-4880-0048 / 297224 / TL7 / SCT	letzte Änderung / updated 2022-11-04	Datum / <i>Date</i> 1996-04-15
	s Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweis upplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 91		
	okoppler ocoupler		
	n) / Type(s)		
61]	II O 624 GB_V001 / -V01/6-7-9-0\		
62]	ILQ 621 GB-X001 / -X01(6;7;8;9) ILQ 30-X001 / -X01(6;7;8;9)		
63]	ILQ 31-X001 / -X01(6;7;8;9)		
64]	ILQ 32-X001 / -X01(6;7;8;9)		
65]	ILQ 55-X001 / -X01(6;7;8;9)		
66]	ILQ 66X001 / -X01(6;7;8;9)		
67]	ILQ 620-X001 / -X01(6;7;8;9)		
68]	ILQ 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)		
69]	SFH1617A-y-X001 / -X01(6;7;8;9)		
70]	ILD1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9)		
71]	ILQ1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9)		
72]	TCED1100		
73]	TCED1100G		
74]	TCET1600		
75]	TCET1600G		
76]	TCET2200		
77]	TCET2200G		
78]	TCET2100		
79] 801	TCET2100G		
80] •41			
81] 921	TCET2600G		
82] 83]	TCET4100 TCET4100G		
osj 84]	TCET4100G		
85]	TCET4600		
86]	SFH 6156-3078		
87]	VO615A-X005 / -X05(6;7;8;9)		
88]	VO617A-X005 / -X05(6;7;8;9)		
89]	VO618A-X005 / -X05(6;7;8;9)		
	······································		
	etzung siehe Blatt 5 / nued on page 5		~
Jonan	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certific	cation Institute	
-	Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach		



VDE Prüf- und Zer Zeichengenehmig	tifizierungsinstitut ung	Auswe <i>Certific</i> 91888	ate No. 🛛 Page
	s / Name and registered seat of the Certificate eresienstraße 2, 74072 Heilbronn	holder	
\ktenzeichen / <i>File ref.</i> I22610-4880-0048 / 297224 / TL7	/ SCT	letzte Änderung / <i>updated</i> 2022-11-04	Datum <i> / Date</i> 1996-04-15
	Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweis ction with page 1 of the Certificate No. 91		
Anmerkung	Zusätze zur Typenbezeichnung sieh vom 2022-11-04	e Anlage 100⊤1	
Remark	Suffixes to the type designation see dated 2022-11-04	appendix 100T1	·
Neitere Angaben siehe Anlagen Further information see appendix	100T1 ; 200K1 ; 200K2 ; 300M1 ; 30 100T1 ; 200K1 ; 200K2 ; 300M1 ; 30		
VDE P	rüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certifi	cation Institute	



Vishay Semiconductors

VDE Prüf- ur Zeichengene	nd Zertifizierungsinstitut ehmigung	Ausweis- Certificat 91888	
	ungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate CmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn	holder	
Aktenzeichen / <i>File ref.</i> 422610-4880-0048 / 293	7224 / TL7 / SCT	letzte Änderung <i>i updated</i> 2022-11-04	Datum / <i>Date</i> 1996-04-15
Dieses Beiblatt ist Bestand This Supplement is part of	tteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 91888. the Certificate No. 91888.		
Optokoppler Optocoupler			
Fertigungsstätte(n) Place(s) of manufactu	re		
Referenz/ <i>Reference</i> 30009952	Vishay Semiconductor Malaysia Sdn. Bhd. 1710-1 Krubong Ind. Park Mukim Krubong 75250 MELAKA MELAKA MALAYSIA		
	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certific		DE
Merianstrasse 28, D-63069 C		Telefon +49	(0) 69 83 06-0 (0) 69 83 06-555

Wight or WDE-Confinence Wight of True In VDE-Confinence Wight of True In VDE-Confinence Wight of True In VDE-Confinence Wight of True In Vertice And and Blat Lucin Vertice And Wight of True In Vertice And and Blat Lucin Vertice And Wight of True In Vertice And and Blat Lucin Vertice And Wight of True In Vertice And and Blat Local Wight of True And	المالية المالي مالية المالية الم مالية مالية المالية مالية مال مالية مالية مالي مالية مالية مالي مالية مالية ماليممالية مالية ماليمالية مالية ماليمالية مالية ماليما	ethologian voitage Bail Dagatad	2-11-C	Datum / Date 1996-04-15	
ingang inut sy-Out Footprint / oder Gehäuseform ay-Out Footprint / oder Gehäuseform ay-Out Footprint / or package type ay-Out Footprint / or package type (mm) imutere Kriechstrecke Eingang - Ausgang (mm) imutere Luftstrecke Eingang - Ausgang (mm) imutere Luftstrecke Eingang - Ausgang	Max, periodische Spilzenisolationsspg. Max, repetitive peak isolation voltage V _{юем} [V реаk]	ransient isolation voltage iakj	Э		
Vpe(s) Vp	.gqsanoilsolainea Spilzenisolationsggg. Max. repetitive peak isolation voltage V _{ioRM} [V peak]	ageiton voitageat iakj ekj	Э		
		t mumixeM Viorw [V pe Derschmutz	Pollution de Mimaklasse Mimatic ca	Lagertebstemperature rende Derrebstemperature renge Cperating temperature renge	Storage temperature range Storage temperature
≤ 0,7 ≤	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	+150
SFH 6116X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 ¹⁰ 2 8,0 ¹⁰ 2 8,0 ¹⁰	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	+150
SFH 6156X001 / -X01(6:7:8:9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	-55 +150
	890 10	10 000 2	55/100/21	-55+100 -55	-55 +150
SFH 610AX001 / -X016(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	+150
SFH 611AX001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor		10 000 2	55/100/21	+100	-55 +150
SFH 615AX001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	+150
SFH 617AX001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/110/21	-55 +110 -55	+150
SFH 618A X001 / - X01(6,7;9;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55+100 -55	+150
10 SFH 610AEX001 (X01(6.7,8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	-55 +150
11 SFH 615AA-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	-55 +150
12 SFH 615AGB-X001 / -X01(6;7;8;9) CaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55+100 -55	-55 +150
13 SFH 615AGR-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	-55 +150
14 SFH 612A-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	-55 +150
15 SFH 6194-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21		-55 +150
16 SFH 655A X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor	890 10	10 000 2	55/100/21	-55 +100 -55	-55+150
VDE Proit- und Zentifizieningsinstitui GmbH * Testing and Gertification Institute					(j

Vishay Semiconductors

Revision: 02-Dec-2022

Document Number: 83576

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000



Zeichengenehmigung	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung			Rubrik / Rubric 341				Ausweis-Nr. / Certificate No. 091888	tr./ ∋No. S	Anlage / Appendix 200K 1	
Name und Siz des Genehmigungs-interbens / <i>Name and registered</i> seat of the Centificate holder VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany Desses Batt gilh nur in Avebindung mit Batt des Zoensprennemingensweises Nr. 091888	at of the Centricate holder 74072 Heilbronn, Germany generavies Nr. 091888			Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-004	Aktenzeichen <i>I File ref.</i> 422610-4880-0048/297224/TL7/SCT	224/TL7/SC1		letzte Änderung 2022-11-04	letzte Änderung / <i>updated</i> 2022-11-04	Datum / Date 1996-04-15	ate 4-15
optocouplier											
Position in VDE-Certificate Position in VDE-Certificate Type(s)	juduj BueBuijj	tudhuO tudhuO	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Bangee Kriechstrecke Eingeng - Auster External creepage distance innut. [mm]	Außere Luftsfrecke ⊟ingang - kusteri External clearance input - Output [mm]	Max, periodische Spitzenisolationsspg. Max, repetitive peak isolation voltage V _{IORM} [V peak]	gannneqzanoitelozieluqmi əlsmixsM egetiov noitelost traistreti mumixeM Vrorv [Visaq V] _{Mror} V	Poliution degree Verschmutzungsgrad	Klimakiasse Cilimakic category	Betriebstemperaturbereich Operating femperature range 1°mb [°C]	Lagertemperature range Storage temperature range Teg [°C]
17 SFH 614A-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor		≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
18 SFH 615ABM-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	10,16 "	≥ 8,01)	≥ 8,0 ¹⁾	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
19 SFH 615ABL-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			L	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
20 SFH 615AY-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			L	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
21 SFH 615AB-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor		,		890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
22 SFH 615BC-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			L. I	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
23 SFH 6206X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor			ι. Ι	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
24 SFH 6286X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor				890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
25 SFH 620AX001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor				890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
26 SFH 628AX001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	 		I	890	10 000	2	55/100/21	-55+100	-55 +150
27 SFH 620AA-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	[L	890	10 000	N	55/100/21	-55 +100	-55 +150
28 SFH 620AGB-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor			l	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
29 ILD 1-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	1		l	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
30 ILD 2-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			J	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
31 ILD 3-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			<u>.</u> .	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
32 ILD 5-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 i 150
	VDE Prüf- und Z	VDE Prür- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute	t * Testing and Certifi	ication institute							

Vishay Semiconductors

Revision: 02-Dec-2022

Document Number: 83576



ACher & und Sitz de: HAY Sem es Blatt gitt nu	V DE Frui- una zerunzierungsinsuu	sinstitut			און אין	6			Certificate No.	e No.	Appendix	
	Leichengenchmigung- Name und Sitz des Canetmigung-untabers / Name and registered seat of the Centificate Incider VISHAY Semiconductor GmbH, Therestenstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany Dieses Blatt pitrur in Verbindung mit Blett 1 des Zeichengenehmegungsausvelses Nr. 091888.	ast of the Certificate holder 74072 Heilbronn, Germany gseuweise Nr. 091888 .			Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-004	ati Akterizeichen / File ref. 422610-4880-0048/297224/TL7/SCT	224/TL7/SC		091 555 lazte Änderung 2022-11-04	091 868 leizite Änderung / updated 2022-11-04	200K1 Datum / Date 1996-04-15	bate 4-15
Optocoupler Optocoupler	s only vavio in conjunction twin page 1 of the Certifica er	aia Mo. UG 1000										
Type(s) Type(s) Position in VDE-Certificate		າກປະທ ອີນຂອບເອັ	BregeuA IndhO	لـعy-Out Footprint / oder Gehäusetom لـعy-Out Footprint / or package type (۳۳)	Åußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Außere Luffstrecke Eingang - Ausgang External clearance input - Output [mm]	Max, periodische Spilzenisolationaspg. Max, repetitive peak isolation voltage V _{ioem} [V peak]	gnunnsqaanoitsloaisluqmi etsmixsM egettov noitsloai tneianeu mumixsM Vorm [Увая V] _{мтоі} V	Persofmutzungsgree Pollution degree	Kimatic category Kimatic category	T _{amb} [°C] Derating temperature range Betrebstemperature range	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{sig} [°C]
ILD 74	ILD 74-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 61	ILD 610X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	10,16 ¹)	≥ 8,0 ¹⁾	≥ 8,0 1)	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 61	ILD 615X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			. .	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 62	ILD 621X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	[1.	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 62	ILD 621GB-X001 / .X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			L	890	10 000	~	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILCT 6	ILCT 6-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			·	690	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
MCT 6	MCT 6-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 61	ILD 616-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	I I		· .	890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 30	ILD 30-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington			ι.	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 31	ILD 31-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington	1		•••••	890	10 000	5	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 32	ILD 32-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington	 		ι.	690	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 55	ILD 55-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington		·	J	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
1LD 66	ILD 66X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington				890	10 000	<u>.</u>		-55 +100	-55 +150
ILD 25	ILD 250-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor]		·	068	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 25	ILD 251-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	1			690	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 25:	ILD 252-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	·		.t	890	10 000		h	-55+100	-55 +150
		VDE Průl- und Ze	VDE Prit- und Zertifizierungsinsitut GmbH * Testing and Certification Institute	4 * Testing and Certi	dication Institute							(j

Vishay Semiconductors

Revision: 02-Dec-2022

SHA

www.vishay.com

Document Number: 83576

All contract of the contraction	VDE Prüf- und Zertifiz Zeichengenehmigung	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitu Zeichengenehmigung	gsinstitut			Rubrik / Rubric 341	<u>ic</u>			Ausweis-Nr. / Certificate No. 091888	и. / е No. 8	Anlage / Appendix 200K1	
Decomposition Decompos	Name und Sitz des Genetimi VISHAY Semiconduct Dieses Blatt gilt nur in Verbin This sunniement is only usily	gungs-Inhabers / Name and registered for GmbH, Theresienstraße 2, dung mit Blatt 1 des Zeichengenehmig, in consinnetion with come 1 M free Gerhig.	: seat of the Certificate holder 74072 Heilbronn, Germany ungeauswetee Nr. 091888 seas An. 001888			Aktenzeichen 422610-48	u File ref. 380-0048/297	:224/TL7/SC	L	letzte Änderung 2022-11-04	leitzte Änderung / updated 2022-11-04	Datum / Date 1996-04-15	Date 4-15
No. No. No. No. 110 1250-000 1706(3) 110 1250-000 1706(3) 110 1250-000 1706(3) 110 1250-000 10000 110 12400 10000 110 124000 100000 </th <th>Optokoppler Optocoupler</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>-</th> <th></th> <th>- Andronautic - Indonesia - Yama - Andrea</th> <th>and a second second</th>	Optokoppler Optocoupler									-		- Andronautic - Indonesia - Yama - Andrea	and a second
	Position in VDE-Certificate Typ(en)			-	average type	łudłuO - łudni esnelsib egegeers lemetx⊒	tuqtuO - tuqnt eonaració lemetx∃	epellov nollelozi keeq evilleqen .xeM	egettov noitelosi traisnett mumixeM	eengeb noijuliod	Klimakic category Klimakic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T∞nb [°C]	.1.º% ["C] Storage temperature range Pagertemperature
ILD 620-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Phototransistor 10,16 ¹⁰ 2 8,0 ¹⁰ 890 10 000 ILD 620 GB-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Pantotransistor 890 10 000 ILD 755X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 ILD 755X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 ILD 766X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 ILD 766X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Phototransistor 890 10 000 ILQ 1-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 2-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 4-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 4-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 4-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000		/ -X01(6;7;8;9)		Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 620 GB-X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode (antiparallet) Phototransistor 890 10 000 ILD 756X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode (antiparallet) Danington 890 10 000 ILD 766X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode (antiparallet) Danington 890 10 000 ILD 766X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode (antiparallet) Danington 890 10 000 ILD 766X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode (antiparallet) Danington 890 10 000 ILQ 1.X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 3.X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 4.X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 4.X001 / X01(6;7;8;9) GaAS Diode Phototransistor 890 10 000		/ -X01(6;7;8;9)		Phototransistor	10,16 ¹⁾	≥ 8,0 ¹⁾	≥ 8,0 ¹⁾	890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55+150
LLD 755X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 LLD 766X01 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 LLD 766X01 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 LLD 766X01 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 LLO 1-X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 LLO 2-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 LLO 3-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 LLO 4-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000		001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparaltel)	Phototransistor				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILD 766X001 / -X01(6;7;8:9) GaAS Diode (antiparallet) Darlington 890 10 000 ILO 1-X01 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILO 1-X01 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 1-X01 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 3-X001 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 4-X001 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 5-X001 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000	_	1 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Darlington				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILQ 1-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 </td <td></td> <td>1 / -X01(6;7;8;9)</td> <td>GaAs Diode (antiparallel)</td> <td>Darlington</td> <td></td> <td></td> <td> I</td> <td>890</td> <td>10 000</td> <td></td> <td>55/100/21</td> <td>-55 +100</td> <td>-55 +150</td>		1 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Darlington			I	890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILQ 2-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 3-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 3-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 4-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 6-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 6-1X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000		X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILQ 3-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 5-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 74-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 ILQ 6-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000		X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor			1	890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILQ 5-X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 10 000 890 800 10 000 890 800		X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ILQ 74-X001 / -X01(6;7:8:9) GaAs Diode Pnototransistor 890 10 000 ILQ 615X001 / -X01(6;7:8:9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000		X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
LQ 615X001 / -X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000		-X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
		1 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
60 ILQ 621-X001 / X01(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 890 10 000 2		/ -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	1		۸	890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
61 ILQ 821 GB-X001 / X01(6,7,8;9) GaAs Diode Phototransistor 390 10 000 2		001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	1			890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
62 ILQ 30-X001 / -X01(6;7;8:9) GaAs Diode Darlington 830 10 000 2	· ·	-X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington				890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
ode Darlington 890 10 000		-X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington			J	890	10 000		55/100/21	-55 +100	-55 +150
64 1LQ 32-X001 / -X01(6.7.8:9) GaAs Diode Darlington 2	·	X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington			*	690	10 000	,	55/100/21	-55 +100	-55 7150
VDE Prof. und Zertifizerungsinstitut GmbH - Testing and Certification Institute			VOE Praf- und Ze	schfizierungsinstitut Gmb	H • Testing and Cert	tification Institute							

Vishay Semiconductors

Revision: 02-Dec-2022

SHA

www.vishay.com

10

Document Number: 83576

VDE Zeic	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitu Zeichengenehmigung	jsinstitut			Rubrik / Rubric 341	nic			Ausweis-Nr. / Certificate No. 091888	Nr. / 8 No.	Anlage / Appendix 200K1	~
VISHA VISHA Dieses Bl: This supp	Name und Stu des Genehmgungs-Intraberis Name and ingstered seat of the Centificate Incider VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany Dieses Blatt git rur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungseusveises Nr. 091888 . This supplement is only veid in conjunction with page 1 of the Centificate Jou. 091888	est of the Cartificate Incluer 74072 Heilbronn, Germany spausveises Nr. 091888 . ale Mo. 091888			Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-004	Axtenzeichen / File ref. 422610-4880-0048/297224/TL7/SCT	7224/TL7/SC	F	letzte Änderung 2022-11-04	eizte Änderung / updated 2022-11-04	Datum / Date 1996-04-15	Date)4-15
Optol Optoc	Optokoppler Optocoupler											
Position in VDE-Certificate	<u>1</u> λbe(з) 	<i>‡ndu</i> j 6ue6ui∃	ციⴝცги A tuợtuO	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausegang External creepage distance Input - Output Imm]	gnegeu - gnagang - gnagang External clearance input - Output [mm]	Max, periodische Spitzenisolationsspg. Max, repetitive peak isolation voltage Vioka [V реак]	gnunnsqssnoifsiosislugmi elemixsM egstiov noitsoisi treisnsti mumixsM [มีรอดุ V] _{MTOI} V	Poliulion degree Verschmuzungsgrad	Kimatic calegory Climatic calegory	Betriebstemperature range Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertièmperaturbereich Storage temperature range T _{sie} [°C]
65	ILQ 55-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
66	ILQ 66X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Darlington	10,16 1	≥ 8,0 ¹⁾	≥ 8,0 1)	068	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
67 1	ILQ 620-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	i			890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
68	ILQ 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor				890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
69	SFH1617A-y-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor	Γ			890	10 000	N	55/110/21	-55 +110	-55 +150
- 02	ILD1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000	2	55/110/21	-55 +110	-55 +150
71 1	ILQ1615-y-X001 / -X01(6;7;8;9)	GaAs Diode	Phototransistor				890	10 000	2	55/110/21	-55 +110	-55 +150
. 22	TCED1100	GaAs Diode	Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
22	TCED1100G	GaAs Diode	Phototransistor	10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
74	TCET1600	GaAs Diode (antiparailel)	Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000	~	55/100/21	-55 +100	-55+150
75	TCET1600G	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	890	10 000	N	55/100/21	-55 +100	-55 +150
76	TCET2200	GaAs Diode	Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	690	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
. 11	TCET2200G	GaAs Diode	Phototransistor	10,16 -	. ≥ 8,0	≥ 8,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
78	TCET2100	GaAs Diode	Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	690	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55+150
. 6/	TCET2100G	GaAs Diode	Phototransistor	10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
608	TCET2600	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	7.62	≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
		VDE Prút- und Ze	VDE Pröf- und Zertifizierungsinstitut GmbH • Testing and Certification fastitute	1 * Testing and C	artification Institu	te						

Vishay Semiconductors

Revision: 02-Dec-2022

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000



Image: Second	Construction Construction<	Protection Constant of the rest Antenno 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 20211.04 25510021 20211.04 25510021 25510021 20211.04 25510021 25510021 20211.04 25510021 25510021 20211.04 25510021 25510021 20211.04 25510021 25510021	Accentencie	Name und Sitz des Genehrnigungs-Inhabers / Name and registered see VISHAY Serniconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74	Zeichengenehmigung			341	3			Ausweis-Nr. / Certificate No. 091888	-Nr. / 38 No.	Ante App 200	Anlage / Appendix 200K1
Observation Description Description Description Description CELTAGE Description Description Description Description Description	Phototriansistor 1 <th>Phototransistic 10000 2 55/10021 55/110021<th>Batallei Phototransistor 10,16 Maximale inpulsion degree Phototransistor 10,16 Maximale inpulsionalition voltage Phototransistor 10,16 Maximale inpulsionalition voltage Phototransistor 10,16 Nameli creepage distance input - Output Phototransistor 10,10000 2 55/100021 Phototransistor 10,10000 2 55/100021 Phototransistor 10,000 2 55/100021 <th>Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungs This subplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificale</th><th>t of the Centificate holder 1072 Heilbronn, Germany isusveises Nr. 091888</th><th></th><th></th><th>Aktenzeichen 422610-48</th><th>l File ref. 380-0048/291</th><th>7224/TL7/SC</th><th>F</th><th>letzte Ä 2022-</th><th>nderung / <i>updated</i> 11-04</th><th>1996-04-15</th><th>Date 74-1</th></th></th>	Phototransistic 10000 2 55/10021 55/110021 <th>Batallei Phototransistor 10,16 Maximale inpulsion degree Phototransistor 10,16 Maximale inpulsionalition voltage Phototransistor 10,16 Maximale inpulsionalition voltage Phototransistor 10,16 Nameli creepage distance input - Output Phototransistor 10,10000 2 55/100021 Phototransistor 10,10000 2 55/100021 Phototransistor 10,000 2 55/100021 <th>Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungs This subplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificale</th><th>t of the Centificate holder 1072 Heilbronn, Germany isusveises Nr. 091888</th><th></th><th></th><th>Aktenzeichen 422610-48</th><th>l File ref. 380-0048/291</th><th>7224/TL7/SC</th><th>F</th><th>letzte Ä 2022-</th><th>nderung / <i>updated</i> 11-04</th><th>1996-04-15</th><th>Date 74-1</th></th>	Batallei Phototransistor 10,16 Maximale inpulsion degree Phototransistor 10,16 Maximale inpulsionalition voltage Phototransistor 10,16 Maximale inpulsionalition voltage Phototransistor 10,16 Nameli creepage distance input - Output Phototransistor 10,10000 2 55/100021 Phototransistor 10,10000 2 55/100021 Phototransistor 10,000 2 55/100021 <th>Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungs This subplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificale</th> <th>t of the Centificate holder 1072 Heilbronn, Germany isusveises Nr. 091888</th> <th></th> <th></th> <th>Aktenzeichen 422610-48</th> <th>l File ref. 380-0048/291</th> <th>7224/TL7/SC</th> <th>F</th> <th>letzte Ä 2022-</th> <th>nderung / <i>updated</i> 11-04</th> <th>1996-04-15</th> <th>Date 74-1</th>	Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungs This subplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificale	t of the Centificate holder 1072 Heilbronn, Germany isusveises Nr. 091888			Aktenzeichen 422610-48	l File ref. 380-0048/291	7224/TL7/SC	F	letzte Ä 2022-	nderung / <i>updated</i> 11-04	1996-04-15	Date 74-1
Characterization Confinition Confinition Confinition degree CETT4000 Contracting Contracting Contracting Contracting CETT4000 Contracting Contracting Contracting	Protoctransistor 10,16 Ausgang Protoctransistor 10,16 Ausgang Protoctransistor 10,16 Ausgang Protoctransistor 10,16 Max. repetitive peak isolation voltage Protoctransistor 10,16 Max. repetitive peak isolation voltage Protoctransistor 10,16 Nax. repetitive peak isolation voltage Nax. repetitive peak isolation voltage 10,000 2 350 Protoctransistor 10,16 Nax. repetitive peak isolation voltage Nax. repetitive peak isolation voltage 10,000 2 55,000 Nax. repetitive peak isolation voltage 10,000 2 55,000 Non. I 10,000 2 350 10,000 Non. V 10,000 2 55,000 10,000 Non. V 10,000 2 <	Bigate tell fish Phototransistion 10,00 2 5,1100 2 5,1100 2 5,1100 10,00 <th>Phototransistor 10,16 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 5,100/21 1 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 2 3 3 3 Phototransistor 10,16 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,000 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,000 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,000 2 5,100/21 2 5,100/21 Ph</th> <th>Optokoppler Optocoupler</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Mandalanda of Annala Annala an Annala an Annala an Anna</th> <th></th>	Phototransistor 10,16 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 5,100/21 1 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 2 3 3 3 Phototransistor 10,16 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,16 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,000 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,000 2 5,100/21 2 5,100/21 Phototransistor 10,000 2 5,100/21 2 5,100/21 Ph	Optokoppler Optocoupler										Mandalanda of Annala Annala an Annala an Annala an Anna	
TCET260G Case Diode (antiparalei) Phototransistor 10.16 $28,0$ $28,0$ 10000 2 $55.100/21$ 55100 TCET4100 GaAs Diode (antiparalei) Phototransistor $7,62$ $27,0$ $27,0$ $29,0$ 10000 2 $55/100/21$ 55100 TCET4100 GaAs Diode (antiparalei) Phototransistor $7,62$ $27,0$ $28,0$ $29,0$ 10000 2 $55/100/21$ 55100 TCET4100 GaAs Diode (antiparalei) Phototransistor $7,62$ $27,0$ $28,0$ $29,0$ 10000 2 $55/100/21$ 551100 TCET4400 GaAs Diode (antiparalei) Phototransistor $7,62$ $27,0$ $28,0$ 10000 2 $55/100/21$ 551100 TCET4460 GaAs Diode (antiparalei) Phototransistor $7,62$ $27,0$ 890 10000 2 $55/100/21$ 551100 TCET4460 GaAs Diode Phototransistor $7,62$ $27,0$ $89,0$ 10000	parallel) Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 80 10 000 2 $55/100/21$ 55 Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 7,0 \geq 80 10 000 2 $55/100/21$ 55 Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 8,0 \geq 80 10 000 2 $55/100/21$ 55 Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 8,0 \geq 80 10 000 2 $55/100/21$ 55 Paralle) Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 890 10 000 2 $55/100/21$ 55 Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 8,0 10000 2 $55/100/21$ 55 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 7,0 $28,0$ 10000 2 $55/100/21$ 55 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 10000 2 $55/100/21$ 55 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 10000 2 $55/100/21$	parallel) Phototransistor 10,16 28,0 26,0 10,000 2 56/100/21 -56+100 Phototransistor 7,62 27,0 28,0 10,000 2 55/100/21 -56+100 Phototransistor 7,62 27,0 28,0 890 10,000 2 55/100/21 -56+100 Parallel) Phototransistor 7,62 27,0 28,0 890 10,000 2 55/100/21 -56+100 Parallel) Phototransistor 7,62 27,0 28,0 10,000 2 55/100/21 -56+100 Phototransistor 10,16 2 27,0 28,0 1500 10,000 2 55/100/21 -56+100 Phototransistor 10,16 2 27,0 28,0 10,000 2 55/100/21 -56+100 Phototransistor 10,16 2 28,0 10,000 2 55/100/21 -56+100 Phototransistor 10,16 2 20,00 2	parallel) Phototransistor 10,16 2 8,0 890 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 7,62 27,0 890 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 7,62 27,0 890 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 7,62 27,0 890 10 000 2 55/100/21 Parallel) Phototransistor 7,62 27,0 890 10 000 2 55/100/21 Parallel) Phototransistor 7,62 27,0 890 10 000 2 55/100/21 Parallel) Phototransistor 7,62 27,0 890 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 7,62 2,70 2,8,0 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 2,8,0 2,8,0 1500 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 2,8,0 2,0 1500 2 55/100/21 Phototransistor </th <th>Position in VDE-Certificate Typ(en)</th> <th></th> <th></th> <th>γαλ-Οηί Εοσίριψι / οι package type</th> <th>tuquO - tuqni estense distance input - Output</th> <th>External clearance Input - Output</th> <th>Max. repetitive peak isolation voltage</th> <th>egetiov noitelosi treisnent mumixeM</th> <th></th> <th></th> <th>əpnər ərufərəqmət priterəqO</th> <th>Lagertemperaturbereich Sforage temperature range</th>	Position in VDE-Certificate Typ(en)			γαλ-Οηί Εοσίριψι / οι package type	tuquO - tuqni estense distance input - Output	External clearance Input - Output	Max. repetitive peak isolation voltage	egetiov noitelosi treisnent mumixeM			əpnər ərufərəqmət priterəqO	Lagertemperaturbereich Sforage temperature range
TCET4100 Carlot GaAs Diode Phototransistor $7,62$ $27,0$ $27,0$ $26,1100/21$ $55+100$	Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 7,0 \approx 7,0 \approx 90 10.000 2 $55/100/21$ -55 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 890 10.000 2 $55/100/21$ -55 parallel) Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 7,0 890 10.000 2 $55/100/21$ -55 parallel) Phototransistor 7,62 \geq 8,0 \geq 890 10.000 2 $55/100/21$ -55 parallel) Phototransistor 10,16 2 \geq 8,0 2 2 2 $-56/100/21$ -55 Phototransistor 10,16 2 \geq 8,0 2 2 $-56/100/21$ -55 Phototransistor 10,16 2 \geq 8,0 2 $-50/100/21$ -55 Phototransistor 10,16 2 \geq 8,0 2 $-50/100/21$ -55 Phototransistor 10,16 2 $= 8,0$ 10000	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Phototransistor 7,82 \geq 7,0 890 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 \geq 90 10.000 2 55/100/21 parallel) Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 90 10.000 2 55/100/21 parallel) Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 90 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 7,62 \geq 8,0 \geq 90 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 7,62 \geq 8,0 \geq 8,0 1500 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 1500 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 $=$ 8,0 1500 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 $=$ 8,0 2 2 56/100/21 Phototransistor 10,16 $=$ 8,0 $=$ 8,0 2 2 55/100/21		GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	890	10 000	2	55/100/21	1 :	-55 +150
TCET4100G CaAs Diode Phototransistor 10,16 $\geq 8,0$ $\geq 8,0$ $\geq 8,0$ $\geq 65/100/21$ $\leq 55+100$ ≥ 55	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		GaAs Diode	Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
TCET 4600 Cash Diode (antiparalle) Phototransistor 7,62 2 7,0 890 10 000 2 55+100 55 TCET 4600 GaAs Diode (antiparalle) Phototransistor 10,16 2 8,0 2 8,0 2 55/100/21 55+100 55 SFH 6156-3078 GaAs Diode (antiparalle) Phototransistor 10,16 2 8,0 2 8,0 10 000 2 55/100/21 55+100 55 V0615A-3078 GaAs Diode (antiparalle) Phototransistor 7,62 2 7,0 2 8,0 10 000 2 55/100/21 55+100 55 V0615A-3005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 2 8,0 1500 10 000 2 55/100/21 55+100 55 V0615A-3005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 2 8,0 1500 10 000 2 55/100/21 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	paralle() Phototransistor 7,62 \geq 7,0 890 10.000 2 55/10021 paralle() Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 890 10.000 2 55/10021 Phototransistor 7,82 \geq 8,0 \geq 8,0 16000 2 55/10021 Phototransistor 7,62 \geq 7,0 \geq 8,0 10000 2 55/10021 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 10000 2 55/10021 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 10000 2 55/10021 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 \geq 8,0 \geq 5,0 2 Phototransistor 10,16 \geq 8,0 \geq 8,0 \geq 5,0 2 55/10021 Phototransistor Phototransistor $=$ 5,0 $=$ 5,0 2 55/10021 Fiscal f	e	GaAs Diode	Phototransistor	10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55
TCET4600 GaAs Diode (antiparallel) Phototransistor 10,16 2 8,0 2 8,0 10 000 2 55/100/21 -55+100 55 SFH 6156-3078 GaAs Diode Phototransistor 7,62 ≥ 7,0 ≥ 7,0 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 55 VO615A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 7,62 ≥ 7,0 ≥ 8,0 ¹⁰ 1500 10 00 2 55/100/21 -55+100 55 VO615A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 ¹⁰ ≥ 8,0 ¹⁰ ≥ 8,0 ¹⁰ 1500 10 00 2 55/100/21 -55+100 55 VO617A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 ¹⁰ ≥ 8,0 ¹⁰ 28,0 ¹⁰ 1500 10 25 55/100/21 -55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100 55+100	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	parallel) Phototransistor 10,16 28,0 26,0 890 10,000 2 55/100/21 -55 +100 Phototransistor 7,62 27,0 27,0 27,0 15,00 10,000 2 55/100/21 -55 -+100 Phototransistor 10,16 2 2,0 1500 10,000 2 55/100/21 -55 -+100 Phototransistor 10,16 2 2,0 1500 10,000 2 55/100/21 -55 -+100 Phototransistor Phototransistor 10,16 2 2,0 10,000 2 55/100/21 -55 -+100 Phototransistor Phototransistor 1500 10,000 2 55/100/21 -55 -+100 Gestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / 1500 10,000 2 55/100/21 -55 -+100	parallel) Phototransistor 10,16 2.8,0 2.8,0 890 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 7,82 2.7,0 2.6,0 16.000 2 55/100/21 Phototransistor 7,62 2.7,0 2.6,0 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16.10 2.8,0.10 15000 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16.10 2.8,0.10 15000 10.000 2 55/100/21 Phototransistor 15000 10.000 2 55/100/21 1 15000 2 55/100/21 gradies 2.16 10.000 2 55/100/21 1 1 1 2 55/100/21	· · · ·	GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	7,62	0,7 ≤	≥ 7,0	890	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55 +150
SFH 6156-3078 GaAs Diode Phototransistor 7,62 2 7,0 2 7,0 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 55 VO615A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 ¹⁰ 2 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 55 VO615A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 ¹⁰ 2 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 55 VO617A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 ¹⁰ 2 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 -55 VO617A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 -55 VO618A-X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 -55+100 -55+100 -55+100 -55+100 -55+100 -55+100 -55+100 -55+100 -55+100 <td>Phototransister 7,62 ≥ 7,0 ≥ 7,0 1500 10000 2 55/100/21 -55 Phototransister 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10000 2 55/100/21 -55 Phototransister 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10000 2 55/100/21 -55 Phototransister 1500 10 000 2 55/100/21 -55</td> <td>Phototransistor 7,62 ≥ 7,0 ≥ 7,0 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor 10,16 ¹⁰ ≥ 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor 10,16 ¹⁰ ≥ 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 gestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / signates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100</td> <td>Phototransistor 7,82 ≥ 7,0 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 15000 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 10/21 respected is ind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / 1500 10 000 2 55/100/21</td> <td></td> <td>GaAs Diode (antiparallel)</td> <td>Phototransistor</td> <td>10,16</td> <td>≥ 8,0</td> <td>≥ 8,0</td> <td>890</td> <td>10 000</td> <td>2</td> <td>55/100/21</td> <td></td> <td>-55 +150</td>	Phototransister 7,62 ≥ 7,0 ≥ 7,0 1500 10000 2 55/100/21 -55 Phototransister 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10000 2 55/100/21 -55 Phototransister 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10000 2 55/100/21 -55 Phototransister 1500 10 000 2 55/100/21 -55	Phototransistor 7,62 ≥ 7,0 ≥ 7,0 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor 10,16 ¹⁰ ≥ 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor 10,16 ¹⁰ ≥ 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 gestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / signates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100	Phototransistor 7,82 ≥ 7,0 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 10,16 °0 ≥ 8,0 °0 15000 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 10/21 respected is ind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / 1500 10 000 2 55/100/21		GaAs Diode (antiparallel)	Phototransistor	10,16	≥ 8,0	≥ 8,0	890	10 000	2	55/100/21		-55 +150
VO615A.X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 10,16 ¹ 2 8,0 ¹ 2 8,0 ¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 -55 .	Phototransistor 10,16 ¹⁰ 2 8,0 ¹¹ 1500 10 000 2 55/100/21 -55 Phototransistor Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55	Phototransistor 10, 16 °1 2 8,0 °1 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100 gestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / signates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100	Phototransistor 10,16 ¹ 2 8,0 ¹ 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 respected is ind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / isgnates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21		GaAs Diode	Phototransistor	7,62	≥ 7,0	≥ 7,0	1500	10 000	7	55/100/21	-55 +100	-55 +150
VO617A.X005 / X05(6;7;8;9) GaAs Diode Phototransistor 1500 10 2 55//100/21 -55 +100 <th< th=""><td>Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55</td><td>Phototransister 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 -55 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 -55 rgestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / signates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 -55</td><td>Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 rgestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / isgnates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21</td><td></td><td>GaAs Diode</td><td>Phototransistor</td><td>10,16 ¹⁾</td><td>N 8,0 1)</td><td>≥ 8,0 ¹⁾</td><td>1500</td><td>10 000</td><td>2</td><td>55/100/21</td><td>-55 +100</td><td>-55</td></th<>	Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55	Phototransister 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 -55 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 -55 rgestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / signates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 -55	Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 rgestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / isgnates different CTR values 1500 10 000 2 55/100/21		GaAs Diode	Phototransistor	10,16 ¹⁾	N 8,0 1)	≥ 8,0 ¹⁾	1500	10 000	2	55/100/21	-55 +100	-55
VO618A-X005 / -X06(6,7;8;9) GaAs Dicde Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55+100	Phototransistor 2 55/100/21 -55	Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 -55 +100 gestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / signates different CTR values	Phototransistor 1500 10 000 2 55/100/21 rgestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / isignates different CTR values		GaAs Diode	Phototransistor	J			1500	10 000	2	55/100/21		-55 +150
	Anmerkung Typenbezeichnung / Remark type designation :	Anmerkung Typenbezeichnung / Remark type designation : Die freien Stellen in der Typenbzeichnung, die durch Punkte dargestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / The open digits in the type designation, represented by dots, designates different CTR values Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8	Anmerkung Typenbezeichnung / Remark type designation : Die freien Stellen in der Typenbzeichnung, die durch Punkte dargestellt sind, bezeichnen unterschiedliche CTR-Werte / The open digits in the type designation, represented by dots, designates different CTR values ¹⁾ Nur mit Option 6 und Option 8 / Only with option 6 and Option 8		GaAs Diode	Phototransistor				1500	10 000	2	55/100/21	-55 +100	1 11

Vishay Semiconductors

Revision: 02-Dec-2022

SHA)

www.vishay.com

12

Document Number: 83576

For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitu Zeichengenehmigung	ngsinstitut			341 341	2007		Ausweis-Nr. / Certificate No. 091838	Appendix 200K2
Name und Sitz des Genetimigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder VISHAY Semiconductor GmbH, Therestienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany Dieses Blatt off nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Mr. 091888. This supplement is only-vefor in conjunction with gage 7 of the Certificate No. 091838	ed seat of the Certificate holder 2, 74072 Heilbronn, Gem igungsausweises Nr. 091888 . <i>tificate</i> No. 091888	many		Aktenzeid 422610	Aktenzeichen / File ref. 422610-4880-0048/297224/TL7/SCT	7224/TL7/SCT	letzte Änderung / updated 2022-11-04	Datum / Date 1996-04-15
Optokoppler Optocoupler								
	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings	jrenzwerte 3s						
siawawA⊒dvm in odiitoate Position in VDE-Certificate Type(s) Type(s)	Maximalet Eingangsstrom Maximalet Eingangsstrom Maximuminput current	mottssgnegeuA telemixeM tnernus tuqtuo mumixeM [Am] osl	gnutsieltsuhevegangsverkustielt Max, output power dissipation [Wm] _{os} 9	(Dersted) Max. Umgebungstemperature T₅ [°C] (Dersted)	Klassifizierung für SMT Klassifizerung för SMT nach i acriding IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lölbadmethodi Klassifizerung für Lölder bath met Klassifizerung für Lölpe	nsisG ərkilistesuz sgnitst notitbbA	
1 SFH 6106X001 / -X01(6;7;8;9)	275	н 	400	175	260°C/10s	0 -) 2)	
2 SFH 6116X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	1			
3 SFH 6156X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175				
4 SFH 6186X001 / -X01(6;7,8;9)	275	1	400	175				
5 SFH 610AX001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	F			
6 SFH 611AX001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175				
7 SFH 615AX001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175				
8 SFH 617AX001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175				
9 SFH 618AX001 / -X01(6;7;8;9)	275	•	400	175				
10 SFH 610AEX001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175				
11 SFH 615AA-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	F	400	175				
12 SFH 615AGB-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	<u> </u>			
13 SFH 615AGR-X001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175				
14 SFH 612A-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175				
15 SFH 619A-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	4	400	175				
16 SFH 655A-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175				
17 SFH 614A-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175	ı—-I			
	>	VDE Prof. und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute	ngsinstitut GmbH * Testir	ng and Certification Insti	ftute			J

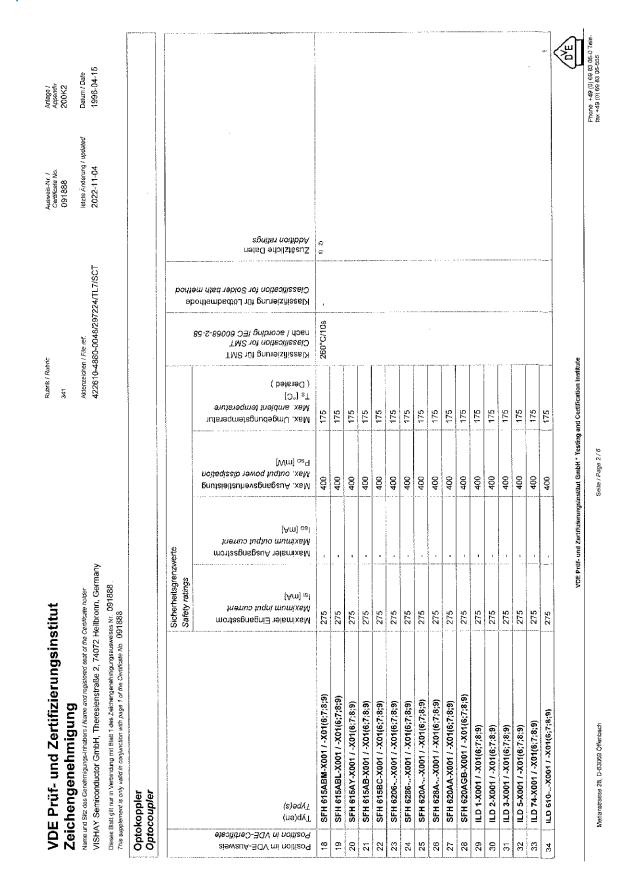
SHAY

www.vishay.com

Document Number: 83576

VDE Certificate 91888

Vishay Semiconductors



Revision: 02-Dec-2022

14

Document Number: 83576

For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u> THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT

ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUM ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT <u>www.vishav.com/doc?91000</u>

VDE Certificate 91888

Vishay Semiconductors



www.vishay.com

	v DE Frui- una zerunzierungsinsulut Zaiakanzaankmizuna			341	2		Centif 091	Certificate No. 091888	Appendix 200K2
zercnengenenmigung									
Name und Sitz des Genetimigungs-timabers / <i>Name aud registered seat of the Centificate holder</i> VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Germany Dieses Blait gift nur in Verbindung mit Blait 1 des Zaichengenehmigungsausweises no. 091888 .	at of the Cartificate noticer 4072 Heitbronn, Germa sausweises Nr. 091888 ,	Aue		Aktenzeid 422610	Аккепzеістел / Fi/е тек. 422610-4880-0048/297224/TL.7/SCT	7224/TL7/SCT	letzte 202:	letzte Änderung / updated 2022-11-04	Datum / Date 1996-04-15
ins suprements is only raid in conjunction with page 1 of the Centricate No. U31000 Optokoppier Optocoupler	100 000 DA 10000				·				
	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings	nzwerte							
siawai m VDE-Certificate Position in VDE-Certificate Type(s) Type(s)	maklet Eingsngsstrom Maximalet Eingsngsstrom Maj Ian] Isi [m]]	motizzgnsgeud telsmitzeM fnenup tugtuo mumitzeM [Am] ost	grutsieltsuhevsgnegeuA .xeM notteqissib tewoq tuqtuo .xeM [Wm] o₂٩		Klassifizierung für SMT SM2 for for for SMT N2 Difforiton for SM2 N3Ch / acording /EC 60062-2-68	boffembsdföd tilt ganneisfiteselX Hen rited veblo2 tot notisoffisselC	nəjaQ ənəindikabuZ s <u>prinər noihbbA</u>		
35 ILD 615X001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175	260°C/10s		1) 2)		
36 ILD 621X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	T				
37 ILD 621GB-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175					
38 ILCT 6-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	r				
39 MCT 6-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	r				
40 ILD 616-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	I	400	175					
41 ILD 30-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175					
42 ILD 31-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175					
43 ILD 32-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	r	400	175					
44 ILD 55-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	1				
45 ILD 66X001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175	1				
46 ILD 250-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	F	400	175	r				
47 ILD 251-X001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175	ı				
48 ILD 252-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	Τ				
49 ILD 255-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	•	400	175					
50 ILD 620-X001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175					1
51 ILD 620 GB-X001 / -X01(6,7;8;9)	275		400	175	r				
									~
	VDE	Prüf- und Zertifizierung	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute	g and Certification Insti	tute				Ţ

Document Number: 83576

VDE Certificate 91888

Vishay Semiconductors



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitu Zeichengenehmiaung	ngsinstitut			HUDTIK / HUDTIC 341	ubric		Ausweis-Nr. / Certificate No. 091888	Anlage / Appendix 200K2	
Name und Stiz des Genehmägungs-Inhabens / Name and registered seat of the Centrate holder VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Gen VISHAY Semiconductor GmbH, Theresienstraße 2, 74072 Heilbronn, Gen	ed seat of the Centificate holder 2, 74072 Heilbronn, Germany	напу		Aktenzeich 422610-	Aktenzalchen / File røf. 422610-4880-0048/297224/TL.7/SCT	224/TL7/SCT	latzte Ändenung / updated 2022-11-04	Datum / Date 1996-04-15	
Deeues clarit gut rui in venomoung mit clarit roes zekreningenentmigungsausweses nr. US 1000 Tris supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Cartificate Ao. 091888 Optokoppiler Optocoupyler	ingungsauswerses Nr. US 10000 trifficate No. 091838								
	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings	enzwerte s	and the second se	han she was a subject of the state of the st					
Position in VDE-Centificate Position in VDE-Centificate Type(s)	Maximaler ⊟ngangsstrom Maximaler ⊟ngangsstrom Ia ∏Am] [Am]	montesgnagaud naiamixsM Maximum output current Ism] osl	Rax, Ausgangaverlustleistung Max, output power dissipation P _{oo} [mW]	Max. Ungebungstemperatur Max. Ungebungstemperature f. Derated)	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / acording IEC 60068-2-58	Missifizierung für Löbaderbah Nem fiss von 2010 Stor Date Construction for Solder ben	nəlsə Dərbi başı sgriftar nottibb A		
52 ILD 755X001 / -X01(6;7;8;9)	275	5	400	175	260°C/10s	-	2)		
53 ILD 766X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175	·				
54 ILQ 1-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	4	400	175	I ~~ · ·				
55 ILQ 2-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	•	400	175					
56 ILQ 3-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	r				
57 ILQ 5-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175					
58 ILQ 74-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	•	400	175	1				
59 ILQ 615X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	r;				
60 ILQ 621-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	•	400	175	f				
61 ILQ 621 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	r · · · ·				
62 ILQ 30-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	r				
63 ILQ 31-X001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175					
64 ILQ 32-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	1	400	175	r				
65 ILQ 55-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	•	400	175					
66 ILQ 66X001 / -X01(6;7;8;9)	275	•	400	175					
67 ILQ 620-X001 / -X01(6;7;8;9)	275		400	175				:	
68 ILQ 620 GB-X001 / -X01(6;7;8;9)	275	-	400	175					ay i
									Æ
		E Pruf- und Zertifizierun	gsinstitut GmbH * Test	VDE Prof- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute	tute			J.	ſ

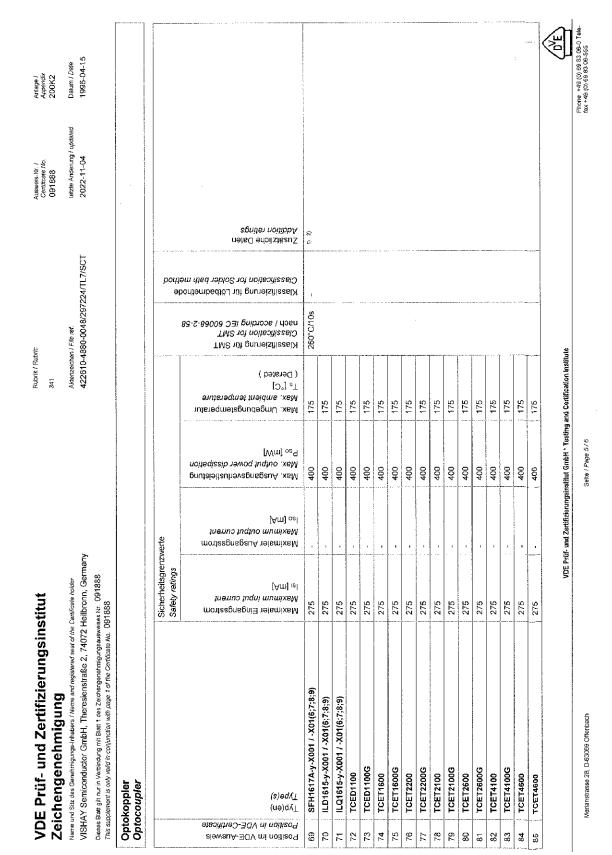
Vishay Semiconductors

Revision: 02-Dec-2022

SHA

www.vishay.com

Document Number: 83576



Vishay Semiconductors

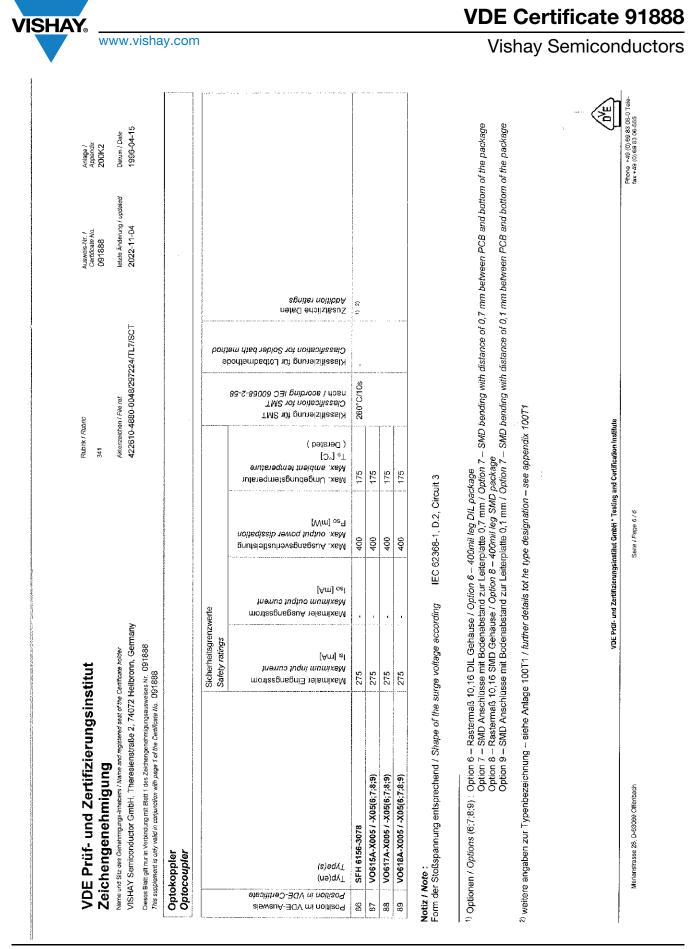
Revision: 02-Dec-2022

17 For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com Document Number: 83576

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT

ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishav.com/doc?91000





Revision: 02-Dec-2022

Document Number: 83576

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT

ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishav.com/doc?91000



accord of a defendance international and a contract hole. Viet A manual and a net vietname of the defendance international and a contract hole. Viet A manual and a net vietname of the defendance international and a contract hole. Viet A manual and a net vietname of the defendance international and a contract hole. Note: The defendance international and a contract hole. Note: The defendance internation of the defendance international and a contract hole. Note: The defendance internation of the defendance international and a contract hole.	Mare und Siz, des Generhischers intere auf Angeleeut saar of the Conflictee None. VISUAY Semiconductor Crebit. Thereseinstrates. 214072 Helbionn, Cerrmany VISUAY Semiconductor Crebit. Thereseinstrates. 214072 Helbionn, Cerrmany Tase state after unt vibrationary materia and anglese 2, 74072 Helbionn, Cerrmany Tase state after unt vibrationary materia. Tase state after unt vibrationary materia. Tase state after unt vibrationary materia. Diptokopher Tase state after and the control of the control o	AMenzeichen / File ref. 422610-4886-0048/397224/TL 7/SCT	091888	100T1
VDE Kennzelchnung VDE Kenzelchnung VDE Kenzelchnung	VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE marking VDE Kennzeichnung VDE marking VDE Kennzeichnung VDE marking VDE marking VDE Kennzeichnung VDE marking VDE Kennzeichnung VDE marking VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung	422610-4860-0048/29/224/1L//SCI	letzte Anderung / updated	Datum / Date
ptocoouppler ptocoouppler Typen Familie Typer family Basis Typendezeichnung Basis Typendezeichnung VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung	ptockoppler ptocoupler Typer familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung VDE Kemzeichnung VDE Kemzeichnung VDE Kemzeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Dptions VDE Kemzeichnung VDE Kemzeichnung		2022-11-04	1996-04-15
Typen Familie Typen Familie Type family Basis Typenbezelichnung Basis Type designation Optionen Optionen Optionen VDE Kennzelchnung V VDE Kennzelchnung Sasis Typenbezelchnung VDE marking Sasis Typenbezelchnung Type family Basis Typenbezelchnung Optionen Optionen Options Optionen VDE Kennzelchnung Sasis Typenbezelchnung VDE Kennzelchnung V VDE Kennzelchnung V	Typen Familie Typen Familie Type family Basis Typen designation Basis Type designation Optionen Options UDE Kemizelchnung VDE Kemiselchnung V VDE Kemiselchnung Sasis Type designation VDE Kemiselchnung Optionen VDE Kemiselchnung Sasis Type designation VDE Kemiselchnung Optionen Optionen Optionen VDE Kemiselchnung VDE Kemiselchnung VDE Kemiselchnung VDE Kemiselchnung			
Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Options VDE Kemzeichnung VDE Kemzeichnung Typen Familie Type designation Options VDE Kenzeichnung Basis Typenbezeichnung Dptions	Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Options VDE Kennzelchnung VDE marking UDE marking Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Ditions VDE Kennzelchnung VDE Kennzelchnung	1		
Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Options UDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung VDE marking Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Options Options VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung	Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Options VDE Manting VDE manting Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung UDE Kemzeichnung VDE Kemzeichnung			
Optionen Options VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung Typen Familie Type familie Basis Typenezeichnung Basis Type designation Options VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung	Optionen Options VDE Kemzeichnung VDE marking Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Dations Options VDE Kemzeichnung	ung in der Typen Familie – Nummern und/oder Buchstaben withim the type family – Numbers and/or letters		
VDE Kennzelchnung VDE marking Typen Family Basis Typenbezelchnung Basis Typenbezelchnung Basis Typenbezelchnung Basis Typenbezelchnung VDE Kennzelchnung VDE Kennzelchnung	VDE Kennzelchnung VDE marking Typen Famile Type famity Basis Type designation Basis Type designation Options Options VDE Kennzelchnung VDE Kennzelchnung	bezeichnet unterschiedliche CTR- Werte / <i>different CTR values</i> entwerte und Konstruktion im Vergleich zum Basistyp erhalten bleiben <i>e remains the same</i>	l Only approved as long as th	ne safety ratings and t
Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Basis Typenbezeichnung Options Options VDE Kennzeichnung VDE marking	Typen Famile Type family Basis Type designation Basis Type designation Coptionen Options VDE Kemzelchnung VDE marking			
Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Optionen Options VDE Kennzeichnung VDE Kennzeichnung	Typen Familie Type family Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Options Options VDE Kemzeichnung VDE marking	1		
Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Optionen Options VDE Kennzeichnung VDE marking	Basis Typenbezeichnung Basis Type designation Options Options VDE Kennzeichnung VDE marking		ning year and a real and	
Optionen Options VDE Kennzeichnung VDE marking	Options Options VDE Kennzeichnung VDE marking			
VDE Kennzeichnung VDE marking X001	VDE Kennzeichnung X001 VDE marking	bezeichnet unterschiedliche CTR- Werte / offferent CTR values entwerte und Konstnuktion im Vergleich zum Basistyp erhalten bleiben e remains the same	l Only approved as long as th	he safety ratings and t
				A MARTINA A MAY A MARTINA AND A MAY AN AN A MARTINA AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
		ut GmbH • Testing and Certification Institute		Phone +49 (0) 69 63 06-
VDE Prut- und Zentifizierungsinstitut GmbH 1 Testing and Certification Institute	Nerianstrasse 28. D-63069 Offenbach	e/Pa⊒e1/2	9 -	fax +49 (0) 69 83 06-655

Revision: 02-Dec-2022

Document Number: 83576



Nummern undroder Buchtstaben – bezeichnet unterschiedliche CTR- Werte / Numbers and/or letters – indicates different CTR values Nur zugelassen, solange die Sicherheits-Kennwerte und Konstruktion im Vergleich zum Basistyp erhalten bleiben / Only approved as long as the safety ratings and the construction in comparison to the basic type remains the same
2022-11-04

Revision: 02-Dec-2022

20 For technical questions, contact: <u>optocoupleranswers@vishay.com</u>